

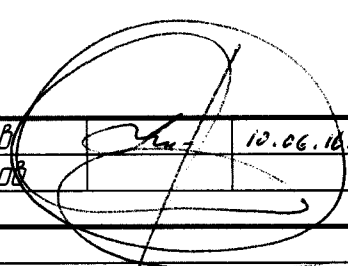
НПК ТЦ	ОГК	Извещение АЕЯР.011-2016	Обозначение см. ниже		
Дата выпуска		Срок изм.		Лист	Листов 1
Причина		Отработка документации по Решению № ОГК/04-16		Код	0
Указание о заделе		На заделе не отражается			
Указание о внедрении		Внедрить по получении извещения			
Применяемость		АЕЯР.431260.146ТУ, АЕЯР.431260.230ТУ, АЕЯР.431260.231ТУ			
Разослать		учтенным абонентам			
Приложение		заменяемый лист № 15 (АЕЯР.431260.146ТУ)			

Изм.	Содержание изменения
26	<p style="text-align: center;"><u>АЕЯР.431260.146ТУ</u> Лист 15 заменить.</p> <p>1 30000 г (на листе 35 в столбце "Примечание" для групп К-9, П-3)</p>

2	<p style="text-align: center;"><u>АЕЯР.431260.230ТУ, АЕЯР.431260.231ТУ</u></p> <p>1 30000 г (в трех местах на листах 14, 24 и 32 (примечание 13)).</p>
---	---

Служба	Отдел	Фамилия	Подпись	Дата
Гл. центр ГКИ	Казинский	Денисов	<i>[Подпись]</i>	10.06.16
			<i>[Подпись]</i>	10.06.16

АО "ЦКБ "Дейтон"	Смирнов	<i>[Подпись]</i>	22.06.16	Н. контроль	Казаков	<i>[Подпись]</i>	10.06.16
Утвердил	Сницар	<i>[Подпись]</i>	10.06.16	512 ВП МО РФ	Франтов	<i>[Подпись]</i>	
Изменение внес							



3 Контроль качества

3.1 Требования к обеспечению и контролю качества в процессе производства

Контроль качества микросхем по ОСТ В 11 0398 с дополнениями и уточнениями, изложенными в настоящем разделе.

3.1.1 Отбраковочные испытания – по ОСТ В 11 0398.

Допускается по согласованию с ВП МО РФ вместо испытаний на воздействие линейного ускорения 10 000 g в случае отсутствия рекламаций проводить для каждой партии микросхем контроль прочности сварных соединений методом 109-4 ОСТ 11 073.013 с проверкой всех соединений на двух микросхемах с допустимой растягивающей силой 0,04 Н±10% (0,004 кгс±10%) и контроль прочности крепления кристалла на сдвиг методом 115-1 ОСТ 11 073.013 на двух микросхемах с величиной сдвигающей силы 2 кгс±10 % (контроль проводится до герметизации).

Функциональный контроль при нормальных климатических условиях, пониженной и повышенной рабочей температуре окружающей среды проводят по методу, указанному в п. 3.3.3.2 ТУ.

Допускается по согласованию с ВП МО РФ проводить ЭТТ в форсированном режиме по РД 11 0755 при повышенной температуре среды +110 °С в течение не менее 48 часов.

Допустимый процент дефектных микросхем, подвергнутых ЭТТ, определяемый по результатам проверки статических параметров в нормальных климатических условиях, должен быть не более 10%.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
26	Эзм	АСР. 011-2016		29.06.16
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

				АЕЯР.431260.146ТУ		Лист
26	Эзм	АСР. 011-2016	Эзм	29.06.16		15
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		